



# 《风光欣》技术资料

\*\*\*\*\*

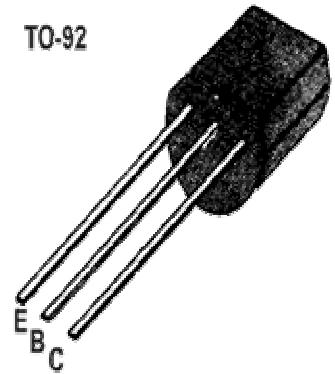
## S 9014

### NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR

主要用途:低电压、低电平、低噪声前置放大等。

绝对最大额定值 ( Ta=25 )

项 目	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V <sub>CB0</sub>	50	V
集电极-发射极电压	V <sub>CEO</sub>	45	V
发射极-基极电压	V <sub>EBO</sub>	5	V
集电极电流	I <sub>c</sub>	100	mA
集电极耗散功率	P <sub>c</sub>	450	mW
结 温	T <sub>J</sub>	150	
存储温度	T <sub>STG</sub>	-55 ~150	



电参数 ( Ta=25 )

项 目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	I <sub>c</sub> =100 μ A, I <sub>E</sub> =0	50			V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>c</sub> =1mA, I <sub>B</sub> =0	45			V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =100 μ A, I <sub>c</sub> =0	5			V
集电极-基极截止电流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> = 50V, I <sub>E</sub> =0			50	nA
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = 5V, I <sub>c</sub> =0			50	nA
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>c</sub> = 1mA	60	280	1000	
集电极-发射极饱和压降	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = 100mA, I <sub>B</sub> = 5mA		0.14	0.3	V
基极-发射极饱和压降	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>c</sub> = 100mA, I <sub>B</sub> = 5mA		0.84	1.0	V
基极-发射极电压	V <sub>BE(on)</sub>	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>c</sub> = 2mA	0.58	0.63	0.7	V
共基极输出电容	Con F=1MHZ	V <sub>CB</sub> = 10V, I <sub>E</sub> = 0		2.2	3.5	PF
电流增益-带宽乘积	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>c</sub> = 10mA	150	270		MHZ
噪音系数	NF	V <sub>CE</sub> = 5V, I <sub>c</sub> = 0.2mA f=1KHZ, R <sub>s</sub> =2K		0.9	10	dB

Hfe 分档及其标志

分档	A	B	C	D
HFE	60-150	100-300	200-600	400-1000